

Тип микросхемы	$U_{\text{ВЫХ}}^0$ В, <=	$U_{\text{ВЫХ}}^1$ В, >=	$I_{\text{ВХ}}^0$ мА, <=	$I_{\text{ВХ}}^1$ мА <=	$I_{\text{ПОТ}}^1$ мА, <=	$I_{\text{ПОТ}}^0$ мА, <=	$t_{\text{ЭД.Р}}^{1.0}$ нс, <=	$t_{\text{ЭД.Р}}^{0.1}$ нс, <=	Рпот.0 мВт	Рпот.1 мВт	$I_{\text{ВЫХ}}^0$ мА <=	Примечание
133ЛЕ1 Н133ЛЕ1	0.4	2.4	-1.6	0.04	16	27	15	22				Краз.0 = 10 Краз.1 = 20
155ЛЕ1 К155ЛЕ1 КМ155ЛЕ1	0.4	2.4	-1.6	0.04	16	27	15	22			16	Ивх.проб <= 1мА Краз = 10
530ЛЕ1 Н530ЛЕ1 К531ЛЕ1П	0.5	2.5	-2.0	0.05	29	45	5.5	5.5			20	
533ЛЕ1	0.4	2.5	-0.36	0.02	3.2	5.4	20	20				Краз = 10
К555ЛЕ1 КМ555ЛЕ1	0.5	2.7	-0.36	0.02	3.2	5.4	20	20			8	
КР1531ЛЕ1	0.5	2.7	-0.6	0.02	5.6	13.0	3.5	4.8	17.1	7.4		
1533ЛЕ1	0.4	2.5	-0.02	0.02	0.85	3.0	14	14			4	
К155ЛЕ2	0.4	2.4	-1.6	0.04	16	19	15	22			16	Ивх.проб <= 1мА